特許協力条約

PCT

JD 22 JUL 2005

| | والمراجعة المستحدث والمستحدث |
|------|----------------------------------|
| WIPO | Pot |
| | |

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]

| 出願人又は代理人 の書類記号 03-F-100PCT | 今後の手続きについては、様式PCT/ | IPEA/416を参照すること。 | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 国際出願番号 PCT/JP2004/004152 | 国際出願日 (日. 月. 年) 25. 03. 2004 | 優先日 (日.月.年) 27.03.2003 | | | |
| 国際特許分類 (IPC) Int.Cl. H01F10/14, H01F41/18 | | | | | |
| 出願人 (氏名又は名称) 独立行政法人物質・材料研究機構 | | | | | |

| 强立行政法人物資。 |
|---|
| 1. この報告書は、PCT35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第 57 条(PCT36 条)の規定に従い送付する。 |
| 2.この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で4 ページからなる。 |
| 3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. ▼ 附属書類は全部で ページである。 |
| 「V 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照) |
| 「 第 I 欄 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙 |
| b. 「電子媒体は全部で」 (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第 802 号参照) |
| 4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 「第 I 棚 国際予備審査報告の基礎 第 I 棚 優先権 第 I 棚 優先権 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第 IV棚 発明の単一性の欠如 第 V 棚 P C T 35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 第 VI棚 ある種の引用文献 第 VI棚 国際出願の不備 第 m 棚 国際出願に対する意見 |

| 国際予備審査の請求書を受理した日 27.07.2004 | 国際予備審査報告を作成した日 06.07.2005 |
|--|---|
| 名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官(権限のある職員) 菊地 聖子 電話番号 03-3581-1101 内線 3565 |

| 第I欄 | 報告の基礎 |
|-----------------|--|
| 1. <i>: o</i> F | 国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。 |
| | この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査 PCT規則12.4にいう国際公開 PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査 |
| た差替え | 用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付しでいない。) |
| Г | 出願時の国際出願書類 |
| ᅜ | 明細書 第 <u>1-2、4-13</u> ページ、出願時に提出されたもの 第 <u>3</u> ページ*、 <u>2004.07.27</u> 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 <u>ページ*、</u> 付けで国際予備審査機関が受理したもの |
| ᅜ | |
| ᄝ | 図面 第 1-13 |
| 3. F | 補正により、下記の書類が削除された。 財細書 第 |
| 4. F. | この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c)) 「明細書 第 |
| * 4. | に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。 |

| 第V | 第V梱 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第 12 条(P C T 35 条(2))に足める兄牌、 それを裏付ける文献及び説明 | | | | |
|----|---|--------------------|-----|-----------------|--|
| 1. | 見解 | | | | |
| | 新規性(N) | 請求の範囲 _ 請求の範囲 _ | | _ 有 _ 無 | |
| | 進歩性(IS) | 請求の範囲 _ 請求の範囲 _ | 1-8 | _ 有 _ 無 | |
| | 産業上の利用可能性(IA) | 請求の範囲 _ 請求の範囲 _ | 1-8 | _ 有 _ 無 _ | |

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1:JP 2001-101645 A (秋田県) 2001.04.13,全文,第1-10図

文献2:JP 2002-208129 A (日立マクセル株式会社)

2002.07.26,段落番号【0026】-【0031】,第1図

& WO 02/39433 A & AU 1274302 A

文献3:JP 2002-216330 A (株式会社東芝)

2002.08.02,段落番号【0025】-【0035】

第1, 4, 9図

& US 2002-098383 A

請求の範囲1-8

文献1には、高密度情報記録媒体及びその媒体の製造方法において、基板上にMg O膜及びMg OやNi Oなどからなる下地膜40が形成され、その上に、Fe、Fe -Ni合金などから成る層30と,Mg Oなどの非磁性材料から成る層20と、Fe Pt規則合金のL10形規則合金情報記録層10とが順次形成された情報記録媒体、及び、膜厚13nmのFe Pt合金(原子組成比としてFe/Pt=1)スパッタターゲットを用いたRFスパッタ法により、基板温度300℃で成膜する点、及び、非磁性材料から成る層20は、採用する非磁性材料によって、L10形規則合金薄膜層の結晶性、結晶配向性を制御することができ、Mg Oを用いた場合、L10形規則合金情報記録層10の結晶性、結晶配向性を向上させる点が記載されている。

補充欄

いずれかの脚の大きさが足りない場合

第 V.2 欄の続き

文献 2 には、磁気記録媒体において、Feeclefter eelefter eelef

なお、国際調査報告で示した文献 3 には、磁気記録媒体において、Fe:Pt の組成比が $4:6\sim6:4$ の範囲が好ましく、この範囲であれば L10 構造を有する規則相が形成される点が記載されている。

しい FePt 磁性薄膜とその製造方法を提供することを課題としている。

この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、第1には、原 子組成が、次式

FexPt_{100-X}

 $(19 < x \le 45)$

で表わされることを特徴とする FePt 磁性薄膜を提供する。

また、この出願の発明は、第2には、100nm 未満の膜厚で L10 構造を 有することを特徴とする上記の FePt 磁性薄膜を提供する。

第3には、単結晶基板またはその表面の酸化物下地層の上に成膜されていることを特徴とする FePt 磁性薄膜を、第4には、下地層としての遷移金属および貴金属のうちの1種または2種以上による薄層を介して成膜されている FePt 磁性薄膜を、第5には、薄層が、単層または多層であることを特徴とする FePt 磁性薄膜を、第6には、薄層が、Fe、Ag、Ni、Co および Cr のうちの1種または2種以上からなる層と、Au、Pt、および Cu のうちの1種または2種以上からなる層とにより構成されていることを特徴とする FePt 磁性薄膜を提供する。

そして、この出願の発明は、第7には、以上の FePt 磁性薄膜の製造方法であって、単結晶基板、酸化物下地層を設けた基板、あるいは下地層としての遷移金属および貴金属のうちの1種または2種以上による薄層を設けた基板に、温度 240℃~500℃の範囲でスパッタ成膜することを特徴とする FePt 磁性薄膜の製造方法を、第8には、温度 300℃以下でスパッタ成膜することを特徴とする FePt 磁性薄膜の製造方法を提供する。

以上のとおりのこの出願の発明は、発明者による検討の結果得られた全く新しい知見に基づいて完成されている。すなわち、スパッタ法により FePt 薄膜を作製する際に、組成を Fe_{50} Pt $_{50}$ (at. %) の化学量論組成から Pt-rich 側にずらすことにより、膜面垂直方向に配向し、かつ結晶磁気異方性が大きい FePt 規則合金薄膜の低温合成を可能としている。

すなわち、この出願の発明では、低温における FePt の規則化の組成

請求の範囲

1. (補正後) 原子組成が、次式

FexPt_{100-X}

 $(19 < x \le 45)$

で表わされることを特徴とする FePt 磁性薄膜。

- 2. 100nm 未満の膜厚で L10 構造を有することを特徴とする請求項 1 の FePt 磁性薄膜。
- 3. 単結晶基板またはその表面の酸化物下地層の上に成膜されている ことを特徴とする請求項1または2の FePt 磁性薄膜。
- 4. 下地層としての遷移金属および貴金属のうちの1種または2種以上による薄層を介して成膜されている請求項3のFePt 磁性薄膜。
- 5. 薄層が、単層または多層であることを特徴とする請求項4のFePt磁性薄膜。
- 6. 薄層が、Fe、Ag、Ni、CoおよびCrのうちの1種または2種以上からなる層と、Au、Pt、およびCuのうちの1種または2種以上からなる層とにより構成されていることを特徴とする請求項5のFePt 磁性薄膜。
- 7. 請求項1ないし6のいずれかの FePt 磁性薄膜の製造方法であって、単結晶基板、酸化物下地層を設けた基板、あるいは下地層としての遷移金属および貴金属のうちの1種または2種以上による薄層を設けた基板に、温度240℃~500℃の範囲でスパッタ成膜することを特徴とする FePt 磁性薄膜の製造方法。
- 8. 温度 300℃以下でスパッタ成膜することを特徴とする請求項7の FePt 磁性薄膜の製造方法。